

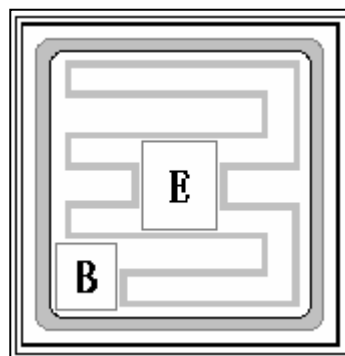


A92 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：A072AJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：720×720μm²
 焊位尺寸：B 极 95×95μm²；E 极 100×100μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：MPSA92，HA92

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压..... -300V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -300V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... -5V
 I_C——集电极电流..... -500mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-300			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-300			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-100μA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-250	nA	V _{CB} =-200V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V _{EB} =-3V, I _C =0
I _{CES}	集电极—发射极截止电流			-100	nA	V _{CE} =-300V, V _{BE} =0
h _{FE}	直流电流增益	25				V _{CE} =-10V, I _C =-1mA
		40		300		V _{CE} =-10V, I _C =-10mA
		25				V _{CE} =-10V, I _C =-30mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	I _C =-20mA, I _B =-2mA
	集电极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-60mA, I _B =-6mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-0.9	V	I _C =-20mA, I _B =-2mA
f _T	特征频率	50			MHz	V _{CE} =-20V, I _C =-10mA, f=100MHz